

Физика и техника полупроводников, 2022, том 56, выпуск 2

XVII Межгосударственная конференция "Термоэлектрики и их применения --- 2021" (ISCTA 2021), Санкт-Петербург, 13-16 сентября, 2021

Япрынцева Е.Н., Иванов О.Н., Васильев А.Е., Япрынцев М.Н.

Микроструктура и термоэлектрические свойства среднеэнтропийных соединений $\text{BiSbTe}_{1.5}\text{Se}_{1.5}$ и PbSnTeSe , полученных реакционным искровым плазменным спеканием

141

Грабов В.М., Урюпин О.Н.

Влияние дендритной неоднородности на термоэлектрические свойства кристаллов $\text{Bi}_{0.88}\text{Sb}_{0.12}$

145

Демидов Е.В., Грабов В.М., Комаров В.А., Суслов А.В., Гергега В.А., Крушельницкий А.Н.

Рост концентрации носителей заряда в тонких пленках висмута

149

Ефимов Д.Д., Комаров В.А., Каблукова Н.С., Демидов Е.В., Старицын М.В.

Блочные и монокристаллические пленки сплава висмут--сурьма 3-12 ат% с подслоем сурьмы

156

Иванов Д.К., Иванов К.Г., Урюпин О.Н.

Ленточный термоэлектрический генератор из углеродного волокна

161

Elschly E.M., El-Khouly A., Hassan Mohamed Asran, Новицкий А.П., Карпенков Д.Ю., Пашкова Д.С., Чеченин Н.Г., Uchimoto T., Miki H., Пархоменко Ю.Н., Ховайло В.В.

Влияние углеродных нанотрубок на термоэлектрические свойства сплавов Гейслера p- и n- типа

164

Вейс А.Н., Лукьянова Л.Н., Усов О.А.

Оптическое поглощение, связанное с межзонными и межподзонными переходами электронов в теллуриде висмута

169

Макарова Е.С., Асач А.В., Тхоржевский И.Л., Фомин В.Е., Новотельнова А.В., Митропов В.В.

Исследование влияния технологических факторов на неопределенность результатов измерения теплопроводности методом лазерной вспышки

173

Суслов А.В., Гергега В.А., Грабов В.М., Демидов Е.В., Комаров В.А.

Деформация тонких пленок полуметаллов методом купольного изгиба подложки

178

Сидоров А.В., Грабов В.М., Зайцев А.А., Кузнецов Д.В.

Влияние ионной подсистемы на термоэлектрический эффект в коллоидных растворах

182

Суворова Е.И., Соломкин Ф.Ю., Архарова Н.А., Шаренкова Н.В., Исаченко Г.Н.

Микроструктура и фазовый состав сплава дисилицидов железа и хрома

187

Публикация материалов Конференции завершена.

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Тысченко И.Е., Хмельницкий Р.А., Сарайкин В.В., Володин В.А., Попов В.П.

Диффузия германия из захороненного слоя SiO_2 и формирование фазы SiGe

192

Электронные свойства полупроводников

Бахадирханов М.К., Зикриллаев Н.Ф., Исамов С.Б., Турекеев Х.С., Валиев С.А.

Влияние наличия достаточно высокой концентрации фосфора на концентрационное распределение галлия в кремнии

199

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Дорофеев С.Г., Кононов Н.Н., Бубенов С.С., Попеленский В.М., Винокуров А.А.

Прыжковая проводимость Мотта и Эффроса-Шкловского в пленках из наночастиц Si , легированных фосфором и бором

204

Уваров А.В., Шаров В.А., Кудряшов Д.А., Гудовских А.С.

Исследование влияния обработки поверхности Si-подложек на морфологию слоев GaP, полученных методом плазмохимического атомно-слоевого осаждения	213
Давыдов С.Ю., Посредник О.В.	
Электронные состояния атомов в монослоях, адсорбированных на карбиде кремния	221
Лебедев А.А., Давыдов В.Ю., Елисеев И.А., Лебедев С.П., Никитина И.П., Оганесян Г.А., Смирнов А.Н., Шахов Л.В.	
Исследование сильно легированных эпитаксиальных пленок n-3C-SiC, выращенных методом сублимации на основе полуизолирующих подложек 6H-SiC	225
Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления	
Смагин В.П., Исаева А.А., Шелепова Е.А.	
Влияние ионов неодима (III) на фотолюминесценцию сульфидов кадмия и цинка в полиакрилатной матрице	229
Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники	
Парфенов П.С., Бухряков Н.В., Онищук Д.А., Бабаев А.А., Соколова А.В., Литвин А.П.	
Исследование подвижности носителей заряда в слоях нанокристаллов PBS методом полевого транзистора	236
Физика полупроводниковых приборов	
Климов А.Э., Голяшов В.А., Горшков Д.В., Матюшенко Е.В., Неизвестный И.Г., Сидоров Г.Ю., Пашин Н.С., Супрун С.П., Терещенко О.Е.	
МДП транзистор на основе пленки PbSnTe : In с подзатворным диэлектриком Al₂O₃	243
Александров О.В., Тяпкин Н.С., Мокрушина С.А., Фомин В.Н.	
Влияние ионизирующего облучения на распределение зарядов и пробой МОП-транзисторов	250
Калинина Е.В., Кудояров М.Ф., Никитина И.П., Дементьева Е.В., Забродский В.В.	
Облучение ионами аргона Cr/4H-SiC-фотоприемников	254